

姓 名	乔良	职 称	副教授
邮 箱	compbridge@sina.com	学 位	博士研究生
研究方向	功率芯片可靠性；AI 与失效分析		
个人简介	副教授，硕士生导师。主讲 C 语言、数据结构等课程。主要研究方向为宽禁带半导体功率器件的可靠性和寿命模型，以及人工智能在功率器件失效分析领域的应用。博士后工作期间作为带头人主持松山湖半导体检测分析实验室建设，通过中国合格评定委员会评审（CNAS: L21455）。近 5 年先后主持科研项目 2 项，参与行业标准制定 5 部，获授权专利 10 项。		
教育简历 (本科起)	大学本科，工学学士 (计算机科学与技术), 燕山大学, 中国, 2002 硕士研究生，工学硕士 (计算机应用技术), 燕山大学, 中国, 2007 博士研究生，理学博士 (光学), 华南师范大学, 中国, 2017		
工作简历	2007.9~今 华北科技学院 2020.3~2025.6 合肥工业大学博士后		
主讲课程	本科课程：数据结构，程序设计语言 C，大学计算机基础，汇编语言		
主要 科研 项目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 功率半导体动态老化测试设备的开发，横向科研 2. GaN HEMT 动态可靠性测试方案研发，横向科研 		
主要 荣誉 获奖	<ol style="list-style-type: none"> 1. 厦门理工学院企业研究生导师 2. 广东省宽禁带半导体材料及器件创新中心主任 		
主要 论文 论著	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一种半导体集成电路加工缺陷检测方法和系统（发明专利） 2. 软开关双向直流变换器的升压模式恒电压控制方法及电路（发明专利） 3. 散热激光投影仪机箱（发明专利） 4. 碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）功率循环试验方法，第三代半导体产业技术创新战略联盟，团体标准 5. 碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）结壳热阻瞬态双界面测试方法，第三代半导体产业技术创新战略联盟，团体标准 		